10/502000

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年8 月14 日 (14.08.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/067580 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/00861

G11B 7/0045, 7/24

(22) 国際出願日:

2003年1月29日(29.01.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-032026 2002年2月8日(08.02.2002) JI

(71) 出願人 *(*米国を除く全ての指定国について*)*: ティーディーケイ株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都 中央区 日本橋一丁目 1 3 番 1 号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 新開 浩 (SHIN-GAI,Hiroshi) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都 中央区 日本

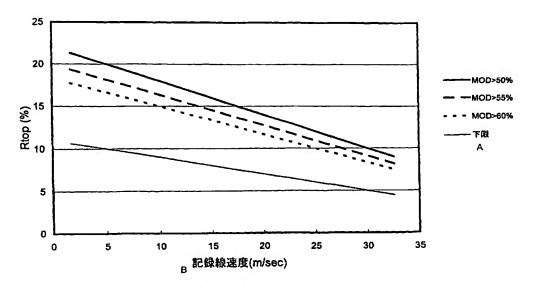
橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ株式会社 内 Tokyo (JP). 加藤 達也 (KATO, Tatsuya) [JP/JP]; 〒 103-8272 東京都 中央区 日本橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ株式会社内 Tokyo (JP). 宇都宮 肇 (UTSUNOMIYA, Hajime) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都 中央区 日本橋一丁目 1 3 番 1 号 ティーディーケイ 株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 大石 皓一, 外(OISHI,Koichi et al.); 〒101-0063 東京都 千代田区 神田淡路町一丁目 4 番 1 号 友 泉淡路町ビル 8 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有]

(54) Title: OPTICAL RECORDING MEDIUM AND METHOD FOR RECORDING INFORMATION ON OPTICAL RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 光記録媒体及び光記録媒体への情報記録方法



A...LOWER LIMIT
B...RECORDING LINEAR VELOCITY (m/sec)

(57) Abstract: An optical recording medium preferable to high speed recording. The optical recording medium comprises a recording layer made of a phase-changing material and enabling data recording at a linear velocity of 10 m/section or more. The reflectance Rtop of the phase-changing material in a crystallized state and the target recording linear velocity V (m/sec) satisfy the following condition. 11 - (V/5) < Rtop < 22 - (2V/5) This ensures 50% or more of modulation degree (MOD), and hence the degradation of jitter caused when data is recorded at a high linear velocity of 10 m/section or more can be effectively suppressed.

/続葉有/

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明は、高速記録を行うのに好適な光記録媒体を提供することを目的とする。本発明による光記録媒体は、相変化材料によって構成され10m/sec以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層を備え、記録層を構成する相変化材料の結晶状態における反射率をRtop(%)とし、目的とする記録線速度をV(m/sec)とした場合、前記Rtop及びVが、

11-(V/5)< Rtop < 22-(2V/5) の条件を満たしている。これにより、50%以上の変調度(MOD)が確保されることから、10m/sec以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となる。

1

明細書

光記録媒体及び光記録媒体への情報記録方法

5 技術分野

本発明は光記録媒体に関し、さらに詳細には、高速記録を行うのに 好適な光記録媒体に関する。また、本発明は光記録媒体への情報記録 方法に関し、さらに詳細には、高いデータ転送レートにて光記録媒体 へ情報を記録することが可能な方法に関する。

10

従来の技術

従来より、デジタルデータを記録するための記録媒体として、CDやDVDに代表される光記録媒体が広く利用されており、そのデータ記録方式としては、記録すべきデータをトラックに沿った記録マークの長さに変調するという方式が広く用いられている。例えば、ユーザによるデータの書き換えが可能な光記録媒体の一種であるDVD-RWにおいては、3T~11T及び14T(Tは1クロック周期)に対応する長さの記録マークが用いられ、これによってデータの記録が行われる。

- 20 このような記録マークの形成においては、レーザービームが光記録 媒体のトラックに沿って照射され、これによって光記録媒体に含まれ る記録層に所定の長さを持ったアモルファス領域が形成され、これが 記録マークとして用いられる。記録層のうちアモルファス状態でない 部分は結晶状態となっている。
- 記録層に記録マークを形成する場合、記録層に照射するレーザビームのパワーを高いレベル(記録パワー)に設定することによって記録層を融点を超える温度に加熱し、その後急冷する。これにより、結晶状態がアモルファス状態に変化し、記録マークが形成される。一方、既に形成された記録マークを消去する場合、記録層に照射するレーザ
 ビームのパワーを比較的低いレベル(消去パワー)に設定することに

20

30

よって記録層を結晶化温度以上に加熱し、その後徐冷する。これにより、アモルファス状態が結晶状態に変化し、記録マークが消去される。したがって、レーザビームのパワーをこのように変調することにより、記録層の未記録領域に記録マークを形成するだけでなく、既に記録マークが形成されている領域にこれと異なる記録マークを直接上書き (ダイレクトオーバーライト) することが可能となる。

近年、光記録媒体に対しては、データ転送レートのさらなる向上が 強く望まれており、これを可能とするためには、結晶化速度の速い相 変化材料を用いて記録層を構成することが有効である。

しかしながら、結晶化速度の速い相変化材料は、一般に結晶状態である場合とアモルファス状態である場合の絶対的な反射率差が小さく、このため、記録されたデータを再生した場合、良好なジッタが得られないという問題があった。しかも、データ転送レートを高めるために記録線速度を高めれば高めるほど、形成された記録マークの幅が細くなる傾向があるため、上記絶対的な反射率差の低下によるジッタの悪化は、記録線速度を高めれば高めるほど顕著となり、記録線速度が10m/sec以上である場合に極めて顕著となる。

このため、記録線速度が10m/sec未満であれば、反射率差の低下によるジッタの悪化はそれほど問題とはならないものの、記録線速度が10m/sec以上になると、反射率差の低下によってジッタが急速に悪化してしまうという問題があった。

発明の開示

したがって、本発明の目的は、高速記録を行うのに好適な光記録媒 25 体を提供することである。

また、本発明の他の目的は、高いデータ転送レートにて光記録媒体へ情報を記録することが可能な情報記録方法を提供することである。

相変化材料からなる記録層が結晶状態である場合の反射率とアモルファス状態である場合の反射率との差は、一般に変調度(MOD)と呼ばれるパラメータによって表現され、これが大きいほど、再生時に

おいて大きな出力振幅を得ることができる。ここで、変調度(MOD)とは、結晶状態である場合の反射率をRtopとし、アモルファス状態である場合の反射率をRbtmとした場合、

MOD = (Rtop-Rbtm)/Rtop ·····(1) 5 で定義される。ここで、「Rtop」及び「Rbtm」とは、それぞれ、 集光されたレーザビームをグルーブに沿ってトラッキングさせたとき の結晶部分及びアモルファス部分の反射率によって定義される。

上記式 (1) から明らかなように、変調度 (MOD) を高めるため

には、RtopとRbtmとの絶対的な差を大きくするか、或いは、
10 Rtopを小さくすれば良いことが分かる。しかしながら、上述のとおり、結晶化速度の速い相変化材料ほど、RtopとRbtmとの絶対的な差は小さくなってしまうことから、十分な変調度(MOD)を確保するためには、Rtopを小さくする必要がある。これは、誘電体膜の膜厚を調整することなどにより実現可能である。

15 本発明の発明者らは、このような技術的知見に基づいて、目的とする (到達可能な) 記録線速度と結晶状態である場合の反射率 (R t o p) との好ましい関係を見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明のかかる目的は、相変化材料によって構成され、 10m/sec以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層を備える 20 光記録媒体であって、前記記録層を構成する相変化材料の結晶状態に おける反射率をRtop(%)とし、目的とする記録線速度をV(m /sec)とした場合、前記Rtop及びVが、

11-(V/5) < Rtop < 22-(2V/5) の条件を満たしていることを特徴とする光記録媒体によって達成され

25 る。

30

また、本発明のかかる目的は、相変化材料によって構成され、10 m/sec以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層を備える光記録媒体であって、記録時において設定すべき線速度V(m/sec)に関する情報を含む記録条件設定情報を有しており、前記記録層を構成する相変化材料の結晶状態における反射率をRtop(%)とした

場合、前記Rtop及びVが、

11 - (V/5) < Rtop < 22 - (2V/5)

の条件を満たしていることを特徴とする光記録媒体によって達成される。

5 本発明によれば、50%以上の変調度(MOD)が確保されること から、10m/sec以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じ るジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となる。

本発明の好ましい実施態様においては、前記Rtop及びVが、

11 - (V/5) < Rtop < 20 - (4V/11)

10 の条件を満たしている。

本発明の好ましい実施態様によれば、5 5%以上の変調度 (MOD) が確保されることから、10m/sec以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化をより効果的に抑制することが可能となる。

15 本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記R t o p 及び V が、

11-(V/5) < Rtop < 18.3-(V/3) の条件を満たしている。

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、60%以上の変調度(M 20 OD)が確保されることから、10m/sec以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化をより効果的に抑制することが可能となる。

本発明の前記目的はまた、結晶状態における反射率がRtop(%)である相変化材料からなる記録層を備えた光記録媒体への情報記録方法であって、記録線速度をV(m/sec)とした場合、

11 - (V/5) < Rtop < 22 - (2V/5)

用つ

25

V ≥ 1 0

を満足する条件にて情報の記録を行うことを特徴とする光記録媒体へ 30 の情報記録方法によって達成される。

25

本発明によれば、50%以上の変調度(MOD)が確保されることから、10m/sec以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となる。

本発明の好ましい実施態様においては、さらに

5 11-(V/5) < Rtop < 20-(4V/11)</p>
を満足する条件にて情報の記録を行う。

本発明の好ましい実施態様によれば、5 5%以上の変調度 (MOD) が確保されることから、10m/sec以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化をより効果的に抑制することが可能となる。

本発明のさらに好ましい実施態様においては、さらに 11-(V/5) < Rtop < 18.3-(V/3) を満足する条件にて情報の記録を行う。

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、60%以上の変調度(M OD)が確保されることから、10m/sec以上の高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化をより効果的に抑制することが可能となる。

図面の簡単な説明

20 図1は、相変化材料により到達可能な記録線速度(V)とこれら相変化材料のRtopとRbtmとの絶対的な差(Rtop-Rbtm)との関係を示すグラフである。

図2は、変調度(MOD)がそれぞれ50%、55%、60%となる場合の到達可能な記録線速度(V)と結晶状態である場合の反射率(Rtop)との関係を示すグラフである。

図3は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体10の構造を概略的に示す断面図である。

図4は、ドライブの主要部を概略的に示す図である。

図5は、2Tに対応する長さの記録マークを形成する場合のパルス 30 パターンの一例を示す図である。

30

図6は、結晶状態である場合の反射率(Rtop)と得られたジッタとの関係を示すグラフである。

発明の実施の形態

5 以下、添付図面を参照しながら、本発明の好ましい実施態様につい て詳細に説明する。

光記録媒体に対して高いデータ転送レートでの高速記録を行うためには、上述のとおり、記録層を構成する相変化材料の結晶化速度を高める必要があるが、各相変化材料により到達可能な記録線速度とこれら相変化材料のRtopとRbtmとの絶対的な差(Rtop-Rbtm)との間には、ほぼ一定の関係を見出すことができる。

図1は、相変化材料により到達可能な記録線速度(V)とこれら相変化材料のRtopとRbtmとの絶対的な差(Rtop-Rbtm)との関係を示すグラフである。

15 図1に示すように、到達可能な記録線速度(V)が高い相変化材料 ほど、RtopとRbtmとの絶対的な差(Rtop-Rbtm)は 小さくなり、その傾向ははぼ直線的であることが分かる。かかる直線 は、下記式(2)によって表すことが可能である。

 $R top-Rbtm = 11-(V/5) \cdots (2)$

20 一方、再生時において十分な出力振幅を得るためには、上述のとおり、記録層の変調度(MOD)を高めることが有効である。また、記録線速度を高めれば高めるほど、形成された記録マークの幅が細くなることから、特に、記録線速度が10m/sec以上である場合においては記録層の変調度(MOD)を十分に高める必要がある。具体的には、記録線速度が10m/sec以上である場合、十分な出力振幅を得るためには50%以上の変調度(MOD)が要求され、55%以上であることが好ましく、60%以上であることがより好ましい。

変調度(MOD)を50%以上とするために必要な条件は、上記式(1),(2)より求めることができる。すなわち、結晶状態である場合の反射率(Rtop)が下記式(3)を満たせば、50%以上の変

調度(MOD)を確保することが可能となる。

$$R \text{ top } < 22 - (2 \text{ V}/5)$$
(3)

また、R t o p の下限値は、式(1) より、アモルファス状態である場合の反射率(R b t m) がゼロとなる値であり、下記式(4) に 5 よって表すことが可能である。

$$R \text{ top} > 11 - (V/5) \qquad \cdots (4)$$

また、変調度(MOD)を55%以上とするために必要な条件及び60%以上とするための条件についても、上記式(1),(2)より求めることができる。すなわち、結晶状態である場合の反射率(Rtop)が下記式(5)を満たせば、55%以上の変調度(MOD)を確保することが可能となり、下記式(6)を満たせば、60%以上の変調度(MOD)を確保することが可能となる。

R t o p <
$$20 - (4 \text{ V} / 11)$$
(5)

$$R \text{ top} < 18.3 - (V/3)$$
(6)

15 図 2 は、変調度 (MOD) がそれぞれ 5 0 %、5 5 %、6 0 %となる場合の到達可能な記録線速度 (V) と結晶状態である場合の反射率 (R t o p) との関係を示すグラフであり、上記式 (3) ~ (6) に対応している。

図2から明らかなとおり、到達可能な記録線速度(V)が高くなる ほど、結晶状態である場合の反射率(Rtop)として設定すべき値 は低くなる。具体的な数値を挙げて説明すると、(1,7)RLLの変 調方式を用いて70Mbpsのデータ転送レート(フォーマット効率 = 80%)を達成しようとする場合、必要となる記録線速度(V)は 10.5m/secであることから、この場合、50%以上の変調度 (MOD)を得るために必要なRtopの値は8.7%~17.4%となり、55%以上の変調度(MOD)を得るために必要なRtopの値は8.7%~15.9%となり、60%以上の変調度(MOD)を得るために必要なRtopの値は8.7%~14.5%となる。同様に、(1,7)RLLの変調方式を用いて140Mbpsのデータ転 30 送レート(フォーマット効率=80%)を達成しようとする場合、必

要となる記録線速度 (V) は 21.0m/s e c であることから、この場合、50%以上の変調度 (MOD) を得るために必要なR t o p の値は $6.4\%\sim12.9\%$ となり、55%以上の変調度 (MOD) を得るために必要なR t o p の値は $6.4\%\sim11.7\%$ となり、60%以上の変調度 (MOD) を得るために必要なR t o p の値は $6.4\%\sim10.7\%$ となる。

次に、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の物理的な構造について説明する。

図3は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体10の構造10 を概略的に示す断面図である。

図3に示すように、本実施態様にかかる光記録媒体10は、基板11と、基板11上に設けられた反射層12と、反射層12上に設けられた第2の誘電体層13と、第2の誘電体層13上に設けられた記録層14と、記録層14上に設けられたバリア層15と、バリア層15上に設けられた第1の誘電体層16と、第1の誘電体層16上に設けられた放熱層17と、放熱層17上に設けられた光透過層18によって構成され、光記録媒体10の中央部分には孔19が設けられている。このような構造を有する光記録媒体10に対しては、光透過層18側からレーザビームを照射することによってデータの記録/再生が行われる。

基板11は、光記録媒体10に求められる機械的強度を確保するための基体としての役割を果たし、その厚さとしては約1.1mmに設定することが好ましい。また、基板11の材料としては特に限定されず、ポリカーボネートを用いることができる。

25 反射層12は、光透過層18側から入射されるレーザビームを反射 し、再び光透過層18から出射させる役割を果たし、その厚さとして は10~300nmに設定することが好ましい。反射層12の材料と しては特に限定されないが、銀を主成分とする合金を用いることが好 ましい。

30 第2の誘電体層13は、主に、その上方に形成されている記録層1

30

4に対する保護層としての役割を果たし、その厚さとしては $2\sim50$ nmに設定することが好ましい。第2の誘電体層13の材料としては特に限定されず、 $A1_2O_3$ 、ZnSと SiO_2 の混合物、 CeO_2 、 Y_2O_3 、A1N等を用いることができる。

記録層14は、相変化材料によって構成され、結晶状態である場合 5 の反射率とアモルファス状態である場合の反射率とが異なることを利 用してデータの記録が行われる。反射率の設定は、記録層14を構成 する相変化材料の組成を調整することにより行われ、上述のとおり目 的とする(到達可能な)記録線速度との関係により決定される。目的 とする(到達可能な)記録線速度は、記録条件設定情報として光記録 10 媒体内に記録され、実際にデータの記録が行われる際には、ドライブ によりかかる記録条件設定情報が読み出され、これに基づいた線速度 でのデータの記録が行われる。ここで、記録条件設定情報とは、光記 録媒体10に対してデータの記録を行う場合に必要な各種条件、具体 的には記録線速度や、その他、例えばレーザビームのパワーや以下に 15 詳述するパルスパターン等を特定するために用いられる情報をいう。 記録条件設定情報は、ウォブルやプレピットとして記録されたもので も、情報の記録時に記録されたものでもよい。また、データの記録に 必要な各条件を具体的に示すもののみならず、ドライブ内にあらかじ め格納されている各種条件のいずれかを指定することにより記録条件 20 の特定を行うものであっても構わない。

結晶状態である記録層14をアモルファス状態に変化させるためには、光透過層18側から照射されるレーザビームを書き込みパワー(Pw)から基底パワー(Pb)までの振幅を有するパルス波形とすることによって記録層14を融点以上の温度に加熱し、その後、かかるレーザビームのパワーを基底パワー(Pb)に設定することによって急冷する。これにより、書き込みパワーPwによって溶融した領域がアモルファス状態に変化し、これが記録マークとなる。一方、アモルファス状態である記録層14を結晶状態に変化させるためには、光透過層18側から照射されるレーザビームのパワーを消去パワー(Pe)

20

30

に設定することによって記録層 1 4 を結晶化温度以上の温度に加熱する。これにより、消去パワーPeによって結晶化温度以上の温度に加熱された領域は、その後徐冷されることから、当該領域が結晶状態に変化する。

5 ここで、書き込みパワーPw、消去パワーPe及び基底パワーPb の関係は、

 $P w > P e \ge P b$

に設定される。したがって、レーザビームのパワーをこのように変調 すれば、記録層14の未記録領域に記録マークを形成するだけでなく、

10 既に記録マークが形成されている領域にこれと異なる記録マークを直接上書き(ダイレクトオーバーライト)することが可能となる。

記録層14の具体的な材料としては、特に限定されるものではないがSbTe 共晶系材料を用いることが好ましい。SbTe 共晶系材料としてはInSbTeGeTb を用いることが好ましい。記録層14の厚さとしては、 $5\sim30nm$ に設定することが好ましい。

第1の誘電体層16は、第2の誘電体層13と同様、主に、記録層14に対する保護層としての役割を果たし、その厚さとしては10~300 nmに設定することが好ましい。第1の誘電体層16の材料としては特に限定されないが、 $ZnS \& SiO_2$ の混合物を用いることが好ましい。

バリア層 15 は、第 1 の誘電体層 16 に含まれる S (硫黄)が記録 層 14 に到達するのを抑制する役割を果たし、その厚さとしては $2\sim 20$ n mに設定することが好ましい。バリア層 15 の材料としては特に限定されず、 $A1_2O_3$ 、SiN、 Y_2O_3 等を用いることができる。

25 但し、本発明において光記録媒体10にバリア層15を設けることは 必須でなく、これを省略しても構わない。

放熱層17は、記録層14に与えられた熱を効率的に放熱させるための層であり、光記録媒体10のパワーマージンを拡大する役割を果たす。したがって、放熱層17の熱伝導率は、少なくとも第1の誘電体層16の熱伝導率よりも高いことが求められ、このような材料とし

15

ては $A1_2O_3$ やA1N等を用いることが好ましい。また、放熱層17の厚さとしては、 $10\sim200$ nmに設定することが好ましく、 $30\sim100$ nmに設定することがより好ましい。但し、本発明において光記録媒体10に放熱層17を設けることは必須でなく、これを省略しても構わない。

光透過層 18 は、レーザビームの入射面を構成し、その厚さとしては $10\sim300$ μ mに設定することが好ましく、 $50\sim150$ μ mに設定することが特に好ましい。光透過層 18 の材料としては特に限定されないが、紫外線硬化性樹脂を用いることが好ましい。

10 次に、本実施態様にかかる光記録媒体10に対してデータの記録を 行うことが可能なドライブについて説明する。

図4は、ドライブの主要部を概略的に示す図である。

ドライブは、図4に示すように光記録媒体10を回転させるためのスピンドルモータ2と、光記録媒体10にレーザビームを照射するとともにその反射光を受光するヘッド3と、スピンドルモータ2及びヘッド3の動作を制御するコントローラ4と、ヘッド3にレーザ駆動信号を供給するレーザ駆動回路5と、ヘッド3にレンズ駆動信号を供給するレンズ駆動回路6とを備えている。

さらに、図4に示すように、コントローラ4にはフォーカスサーボ 追従回路7、トラッキングサーボ追従回路8及びレーザコントロール 回路9が含まれている。フォーカスサーボ追従回路7が活性化すると、 回転している光記録媒体10の記録面にフォーカスがかかった状態と なり、トラッキングサーボ追従回路8が活性化すると、光記録媒体1 0の偏芯している信号トラックに対して、レーザビームのスポットが 自動追従状態となる。フォーカスサーボ追従回路7及びトラッキング サーボ追従回路8には、フォーカスゲインを自動調整するためのオートゲインコントロール機能及びトラッキングゲインを自動調整するためのオートゲインコントロール機能がそれぞれ備えられている。また、 レーザコントロール回路9は、レーザ駆動回路5により供給されるレ ーザ駆動信号を生成する回路であり、光記録媒体10に記録されてい

る記録条件設定情報に基づいて、適切なレーザ駆動信号の生成を行う。 尚、これらフォーカスサーボ追従回路7、トラッキングサーボ追従 回路8及びレーザコントロール回路9については、コントローラ4内 に組み込まれた回路である必要はなく、コントローラ4と別個の部品 であっても構わない。さらに、これらは物理的な回路である必要はな 5 く、コントローラ4内で実行されるソフトウェアであっても構わない。 このような構成からなるドライブを用いて本実施態様にかかる光記 録媒体10に対するデータの記録を行う場合、光記録媒体10に記録 されている記録条件設定情報が読み出され、これに基づいて記録線速 度やレーザビームのパワー、パルスパターン等が決定される。パルス 10 パターンとしては、特に限定されるものではないが、本発明が髙線速 で記録を行う場合に特に効果的であることを考慮すれば、(1,7)R LLの変調方式を用いることが好ましい。(1,7)RLLの変調方式 においては、2T~8Tに対応する長さの記録マークが記録層14に 形成される。 15

図5は、2Tに対応する長さの記録マークを形成する場合のパルスパターンの一例を示す図である。

図5に示されるように、2 Tに対応する長さの記録マークを形成する場合、レーザビームのパルス数は「1」に設定される。ここで、レ 20 ーザビームのパルス数とは、レーザビームのパワーが P w まで高められた回数によって定義される。より詳細には、レーザビームが記録マークの始点に位置するタイミングを時刻 t s とし、レーザビームが記録マークの終点に位置するタイミングを時刻 t e とした場合、時刻 t s から時刻 t e までの間に、レーザビームのパワーが一旦 P w とされ、次に、パワー P b とされる。ここで、時刻 t s 以前におけるレーザビームのパワーは P e に設定されており、時刻 t s においてレーザビームの立ち上げが開始される。また、時刻 t e におけるレーザビームのコウーは P e または P b に設定される。

Tpulseの期間においては、光記録媒体10の記録層14は高 30 いエネルギーを受けてその温度が融点を超え、Tclの期間において

は、光記録媒体10の記録層14は急速に冷却される。これにより、 光記録媒体10の記録層14には、2Tに対応する長さの記録マーク が形成される。

他の長さの記録マーク(3T~8T)を形成する場合も、上記2T 5 に対応する長さの記録マークを形成する場合と同様、レーザビームの パワーがPw、Pe或いはPbに設定され、各々所定数のパルスによ って所望の長さをもつ記録マークが形成される。

以上説明したように、本実施態様によれば、高線速、特に10m/sec以上の線速度でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化 を効果的に抑制することが可能となることから、より高いデータ転送レートでの情報の記録が可能となる。

本発明は、以上の実施態様に限定されることなく、特許請求の範囲 に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発 明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。

15 例えば、上記実施態様においては、光記録媒体10の具体的な構造 として図3に示す構造を挙げたが、本発明による光記録媒体の構造が これに限定されることはない。

以上説明したように、本発明によれば、高線速でデータの記録を行う場合に生じるジッタの悪化を効果的に抑制することが可能となるこ 20 とから、より高いデータ転送レートでの情報の記録が可能となる。

実施例

図3に示した構造を有し、基板11が厚さ1.1mmのポリカーボネートからなり、反射層12が厚さ100nmの銀を主成分とする合 25 金からなり、第2の誘電体層13が厚さ3nmのZnSとSiO2の混合物(モル比=50:50)からなり、記録層14が厚さ14nmのInSbTeGeTbからなり、バリア層15が厚さ5nmのAl2O3からなり、第1の誘電体層16がZnSとSiO2の混合物(モル比=80:20)からなり、放熱層17が厚さ100nmのAlNからなり、光透過層18が厚さ100μmの紫外線硬化性樹脂からな

10

る光記録媒体 $10-1\sim10-4$ を作製した。これら光記録媒体 $10-1\sim10-4$ は、第1の誘電体層16の厚さにおいてのみ互いに相違し、これにより、結晶状態である場合の反射率(R t o p)が互いに相違している。第1の誘電体層16の厚さは、光記録媒体10-1では30nm、光記録媒体10-2では40nm、光記録媒体10-3では42nm、光記録媒体10-4では45nmである。また、記録層14を構成する相変化材料は、線速度を21.0m/sec(フォーマット効率を80%とした場合のデータ転送レートが140Mbps)に設定してデータの記録を行う場合に最適な結晶化速度を有している。

このような光記録媒体 $10-1\sim10-4$ に対し、表1に示す条件のもと、(1,7) R L Lの変調方式を用いて2 T ~8 T に対応する長さの記録マークからなる混合信号を形成した。

表 1

クロック周波数	262.5MHz		
クロック周期(1T)	3.8nsec		
線速度	21.0m/sec		
変調方式	(1,7)RLL		
データ転送レート	175Mbps		
フォーマット効率	80%		
データ転送レート (効率を考慮)	140Mbps		
チャンネルビット長	0.12 μ m/bit		
開口数(NA)	0.85		
レーザ波長	405nm		
Pw	7.0~8.0mW		
Pe	2.2mW		
Pb	0.1mW		

次に、光記録媒体 $10-1\sim10-4$ に形成された混合信号のクロックジッタを測定した。測定においては、タイムインターバルアナライザにより再生信号の「ゆらぎ(σ)」を求め、 σ /Tw(Tw: ϕ 1 ックの1周期)により算出した。測定の結果を表2に示す。表2には、光記録媒体 $10-1\sim10-4$ それぞれについて、記録層14が結晶状態である場合の反射率(Rtop)が併せて示されている。

表 2

10

	Jitter	Rtop
光記録媒体10-1	11.8%	12.5%
光記録媒体10-2	10.9%	11.0%
光記録媒体10-3	10.4%	7.3%
光記録媒体10-4	12.7%	17.0%

ここで、反射率 (Rtop)は、次の方法により算出した。

まず、互いに厚さの異なる反射層 1 2 のみが形成された複数の測定 用媒体を作製し、これら測定用媒体のミラー面部分 (グループやピットを有さない平らな部分) に記録/再生に用いるレーザビームと同じ 波長のレーザビームを照射し、その反射率を分光光度計により測定した。これにより、反射層 1 2 の膜厚と反射率との関係を得た。さらに、これら測定用媒体のミラー面部分に、評価装置を用いて記録/再生に 用いるレーザビームを再生パワーでフォーカスオンさせ、和信号出力 電圧値を測定した。これにより、反射層 1 2 の膜厚と和信号出力電圧 値との関係を得た。

このようにして得られた反射層 1 2 の膜厚と反射率との関係及び反射層 1 2 の膜厚と和信号出力電圧値との関係から、反射率と和信号出力電圧値との関係を導き出した。

15 そして、光記録媒体 10-1~10-4に対し、記録層 14が結晶 状態である領域にグループに沿ってレーザビームを再生パワーでトラッキングさせ、得られた和信号出力電圧値及び上述した反射率と和信 号出力電圧値との関係から当該領域の反射率を算出し、これをRto pとした。尚、Rbtmについても同じ方法により算出することがで 20 きる。

表2に示すように、形成された混合信号のジッタは、結晶状態である場合の反射率 (Rtop) が低い記録層14をもつ光記録媒体ほど

登替之用紙(規則26)

良好な値となっている。次に、表 2 に示す値を用いて、結晶状態である場合の反射率 (R t o p) と得られたジッタとの関係を示すグラフを作成した。

図6は、結晶状態である場合の反射率(Rtop)と得られたジッ 5 タとの関係を示すグラフである。

図6に示すように、結晶状態である場合の反射率(Rtop)と得られたジッタとの間には一定の関係が認められ、結晶状態である場合の反射率(Rtop)が低いほど、ジッタが低下していることが分かった。ここで、光記録媒体10-1の反射率は上述した式(3)を満10 たしており、実用レベルの上限である12%以下(11.8%)のジッタが得られている。また、光記録媒体10-2の反射率は上述した式(5)を満たしており、11%以下(10.9%)のジッタが得られている。さらに、光記録媒体10-3の反射率は上述した式(6)を満たしており、10.5%以下(10.4%)のジッタが得られている。これに対し、光記録媒体10-4の反射率は上述した式(3)を満たしておらず、ジッタが実用レベルの上限である12%を超えていることが分かった。

請求の範囲

1. 相変化材料によって構成され、10m/sec以上の線速度でのデータ記録が可能な記録層を備える光記録媒体であって、前記記録層を構成する相変化材料の結晶状態における反射率をRtop(%)とし、目的とする記録線速度をV(m/sec)とした場合、前記Rtop及びVが、

11-(V/5) < Rtop < 22-(2V/5) の条件を満たしていることを特徴とする光記録媒体。

10

2. 前記R top及びVが、

11-(V/5)< Rtop < 20-(4V/11) の条件を満たしていることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。

15 3. 前記R t o p 及び V が、

11-(V/5)< Rtop < 18.3-(V/3) の条件を満たしていることを特徴とする請求項 2 に記載の光記録媒体。

- 4. 相変化材料によって構成され、 $10\,\mathrm{m/sec}$ 以上の線速度での データ記録が可能な記録層を備える光記録媒体であって、記録時において設定すべき線速度 $V(\mathrm{m/sec})$ に関する情報を含む記録条件設定情報を有しており、前記記録層を構成する相変化材料の結晶状態における反射率をRtop(%)とした場合、前記Rtop及びVが、11-(V/5)< Rtop< 22-(2V/5)
- 25 の条件を満たしていることを特徴とする光記録媒体。
 - 5. 前記R top及びVが、

11 - (V/5) < Rtop < 20 - (4V/11)

の条件を満たしていることを特徴とする請求項4に記載の光記録媒体。

- 6. 前記Rtop及びVが、
- 11-(V/5)< Rtop < 18.3-(V/3) の条件を満たしていることを特徴とする請求項5に記載の光記録媒体。
- 5 7. 結晶状態における反射率がRtop(%)である相変化材料からなる記録層を備えた光記録媒体への情報記録方法であって、記録線速度をV(m/sec)とした場合、

11 - (V/5) < Rtop < 22 - (2V/5)

 $10 \quad V \ge 1 \ 0$

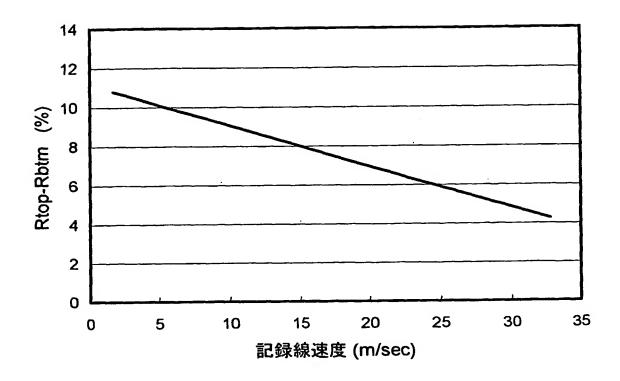
を満足する条件にて情報の記録を行うことを特徴とする光記録媒体へ の情報記録方法。

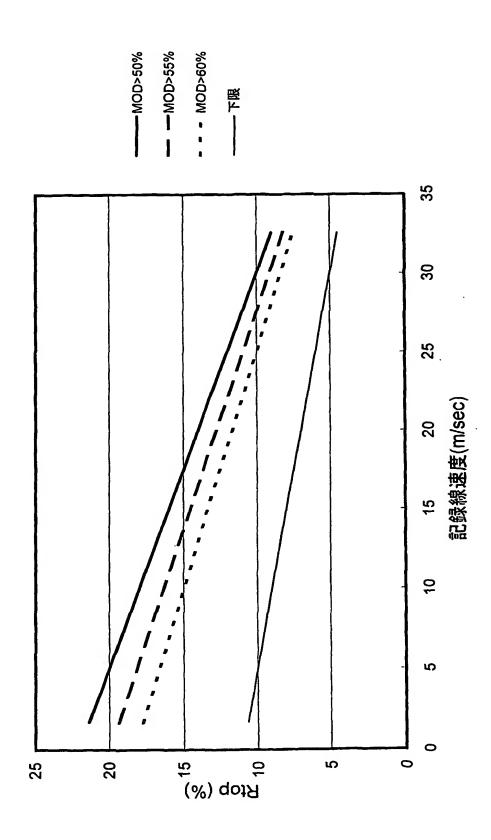
- 8. さらに、
- 15 11-(V/5) < Rtop < 20-(4V/11) を満足する条件にて情報の記録を行うことを特徴とする請求項7に記載の光記録媒体への情報記録方法。
 - 9. さらに
- 20 11- (V/5) < Rtop < 18.3- (V/3) を満足する条件にて情報の記録を行うことを特徴とする請求項8に記載の光記録媒体への情報記録方法。

WO 03/067580 PCT/JP03/00861

1/6

第 1 図



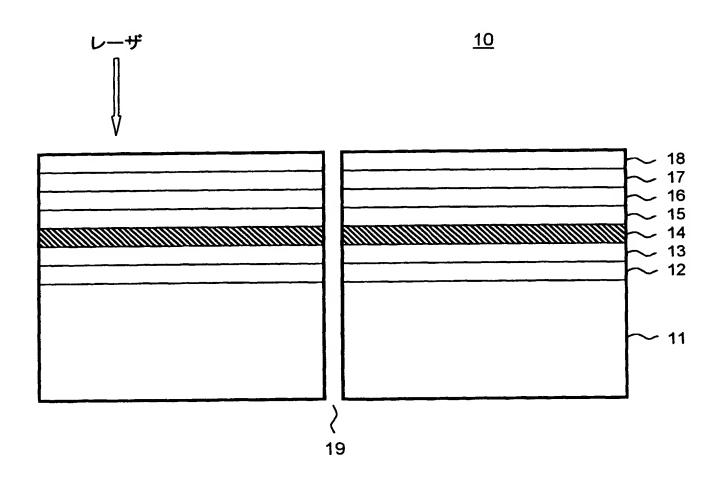


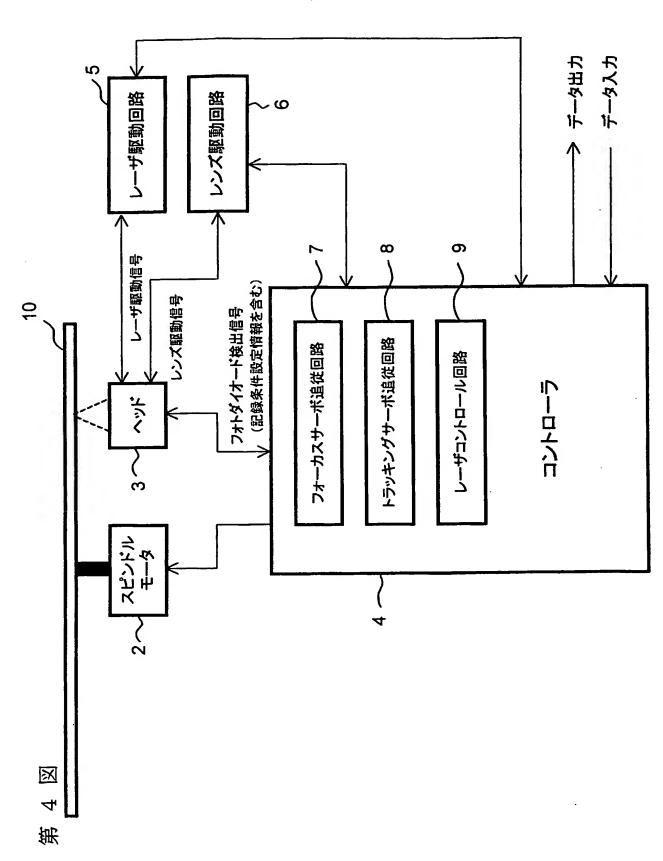
2 図

紙

3/6

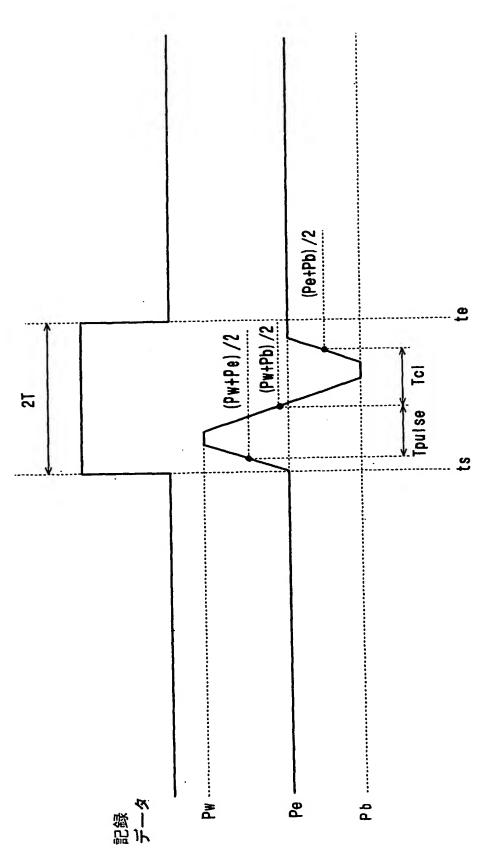
第 3 図





WO 03/067580 PCT/JP03/00861





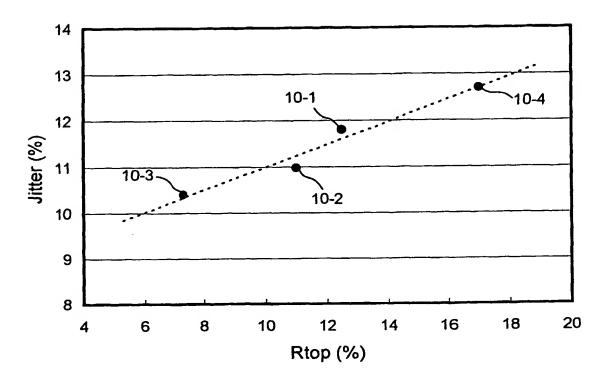
紙

PCT/JP03/00861

6/6

第 6 図

WO 03/067580



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/00861

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G11B7/0045, 7/24							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS	S SEARCHED	av classification symbols)					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G11B7/00-7/013, 7/24, 7/30							
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003							
Electronic d	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	JP 2002-015463 A (NEC Corp.) 18 January, 2002 (18.01.02), Full text (Family: none)	,	1-9				
A	<pre>JP 2002-008269 A (Sony Corp. 11 January, 2002 (11.01.02), Full text (Family: none)</pre>) ,	1-9				
A .	JP 2000-298879 A (Sony Corp. 24 October, 2000 (24.10.00), Full text (Family: none)),	1-9				
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 16 May, 2003 (16.05.03) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family "E" date document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family "A" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or can							
Name and n	nailing address of the ISA/ Inese Patent Office	Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.					

		国際調査報告	!	国除出願番号 —————	PCT/J	P 0 3	/ 0 0 8	b 1
	A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ GllB7/0045, 7/24							
L								
-	B. 調査を行 調査を行った最	テった分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))						
	Int. Cl ⁷ G11B7/00-7/013, 7/24, 7/30							:
	最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本実用新案公報 1922-1996年 日本公開実用新案公報 1971-2003年 日本登録実用新案公報 1994-2003年 日本実用新案登録公報 1996-2003年							
	国際調査で使用した電子データペース(データベースの名称、調査に使用した用語)							
Γ	C. 関連する	ると認められる文献						
Γ	引用文献の カテゴリー*		きけ	その関連する	簡所の表示	A		望する 囲の番号
-	A	JP 2002-015463 A (2002.01.18,全文(ファミ	(日本	電気株式会			1-9	
	Α .	JP 2002-008269 A (2002. 01. 11, 全文(ファミ)		1 – 9	
	Α	JP 2000-298879 A (ソニー株式会社) 2000.10.24,全文(ファミリーなし)					1-9	
	□ C欄の続	きにも文献が列挙されている。		パテントフ	アミリーに関	する別	紙を参照。	·
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献					
	国際調査を完	了した日 16.05.03	国際課	査報告の発送	Ħ	27.0	05.03	}
	日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915		審査官(権限	ŧ—	覼	5 D	3046
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 35						550		